1 5. 高い 撥水機能を持つ 垂直配 向 単層 カーボンナノチューブ膜

丸山 茂夫

はじめに

近年,単層カーボンナノチューブ(SWNT)がナノテクノロジーの基盤材料として,或いは一次元系の物性探索の理想的な材料として,基礎・応用の両面から注目を集めている. SWNT は炭素原子が sp² 結合したグラフェンを,円筒状に丸めた構造を有しており,その構造に起因して様々な特異な物性を有することが知られている⁽¹⁾.具体的には,SWNTの螺旋度(カイラリティ)によって半導体・金属の区別が生じ,半導体の場合にはおおよそ直径によりバンドギャップ幅が決定されることから,これらのバンドギャップ(近赤外~可視に対応)を利用した様々な電子・光学応用が現在活発に提案・研究されている.

このような背景の下, 我々のグループは, CVD 合成の炭素源 としてアルコールを用いることで, 高純度 SWNT のバルク合成 が可能となることを見出した⁽²⁾. さらに, これと Co/Mo 混合酢 酸塩溶液を用いたディップコート触媒担持法とを組み合わせ ることで, シリコンや合成石英などの平滑基板上への SWNT 直 接生成法が開発された⁽³⁾. さらに, CVD 中の触媒活性を高める ことにより, 基板表面に垂直配向した SWNT 膜(VA-SWNT 膜) が成長可能であることが見出された^(4,5). この垂直配向試料で は高純度の SWNT がほぼ一方向に並んでいるため, SWNT の偏 光依存光学特性の検証や⁽⁶⁻⁹⁾. 光学素子としての応用⁽¹⁰⁾などが 期待されている.

最近では、この VA-SWNT 膜が非常に高い撥水性を示すこと を見出された.本試料での接触角 θ は、試料によって非常に広 い範囲に分布(典型的には $115^{\circ} \le \theta \le 150^{\circ}$ 、およびそれ以上の 超撥水性)することが明らかとなった.本節ではまず観測され た高い撥水性に関して述べ、さらに撥水性の原因を探索する予 備的実験を行い、VA-SWNT 膜が有する高撥水性の原因解明に 向けて議論する.

1. 実験試料及び撥水性計測

具体的な試料作成方法は文献^(5,8)に詳しく記述されている. 本方法で作成する VA-SWNT 膜は,現状で 500 nm ~ 30 µm の膜 厚範囲で成長可能である. 膜断面の典型的な電界放出型走査型 電子顕微鏡(FE-SEM)による像を図 1 に示す. 図中の各繊維は, SWNT がファンデルワールス力により束状に集合したバンドル に対応している. 膜上面近傍の拡大図を図 1(b)に示す. これよ りバンドル同士の間隔が 50 nm 程度であること,及び膜上面に はランダムかつ細いバンドルが薄い層(100 ~ 200 nm)として存 在していることが判る. 図 1(b)から,膜が比較的低密度である ことが視認できるが,膜の重量と厚さから見積もった膜重量密 度が約 0.035 [g/cm³]であり,SWNT が細密に充填された密度の 数%の密度である.なお,高解像度透過型電子顕微鏡(HR-TEM) による観測から,本 VA-SWNT は直径 0.8~3.0 nm の分布(平均 直径 ~ 2.0 nm) を有することが判っている⁽⁸⁾.

図2に, 典型的な試料 (sample A) で計測した水滴 (体積: 0.5~1.0 μ l)の拡大望遠鏡写真を数例示す.当試料では, 30 回 の接触角 θ の計測から平均 θ =143°(標準偏差 \approx 4°)と求められ た.しかしながら,試料によって θ は大きな差異を示し,低い 試料では θ =115~130°である一方,超撥水性を示す試料(150° 以上)においては水滴配置そのものが大変困難となる.このよ うな超撥水性を示す試料の接触角計測は,現状では十分な回数 行えておらず,今後我々の水滴配置方法の改良が必要である.

2. 膜上面燃焼の影響

VA-SWNT 膜が図 2 に示すような高い撥水性を示すことについて幾つか原因が推測されるが,1) グラフェン構造の炭素は本

来撥水性である, 2) およそ 50 nm 間隔で疎に存在する SWNT バンドル, に加えて, 3) 膜上面に存在する細くランダムな SWNT バンドルの層, が超撥水性に寄与している可能性が考え られる. この点を検証するため,以下のような実験を行った.

まず用いる試料(sample B)を我々の CVD チャンバー内部, 具体的には Ø26 の石英円筒管の中央^(5,8)にセットし真空引き後, 乾燥空気を 100 sccm・200 Pa で流しながら,管状電気炉を 10 °C/min の速度で昇温した.電気炉には貫通穴が開けてあり,レ ーザー光(488 nm)をこの穴から,試料基板を法線方向に貫通す るように入射し,透過光強度の増加をリアルタイムで計測する ことで膜燃焼量を見積もった.我々の VA-SWNT 試料について の膜厚と吸光度の関係⁽⁵⁾を用いることで,測定された吸光度 は膜厚に換算可能である.

図 3(a)に、電気炉温度に対する透過率(左軸)及び推定膜厚 (右軸)の変化を示す.なお、この条件下での昇温中の燃焼は 主に膜上面で起こると推測される.燃焼はほぼ 600°C を境に急 速に進むが、これは我々の過去の熱重量測定結果とよく一致し ており、このような高い燃焼温度は試料 SWNT の高い純度と欠 陥の少なさを示すものと考えられる.本実験では、燃焼により 膜厚が 8.4 → 7.6 µm と減少したと考えられる.

図 3(b)に, sample B の燃焼前後の濡れ角分布の変化を示す. 赤点(菱点)は平均値, エラーバーは標準偏差のを示している. 燃焼後では有意に撥水性が低下することが判った. この結果からは, 1) 膜上面に薄く存在するランダムな SWNT 層が撥水に 寄与している, と解釈可能な一方, 2) 燃焼過程により SWNT 表面 (或いはキャップが破壊されてできた開口端) に CO や COOH 等の化学基が吸着し濡れ性の低下を引き起こした, とい う解釈も存在し, 以上の実験だけからでは, このどちらが支配 的なのか, 或いはその他のメカニズムが存在しないのか, に関

3

して結論することは出来ない. 今後, この解明する為, 例えば フーリエ変換赤外分光(FT-IR)による膜上面の化学吸着種分析 等が必要と考えられる.

3. まとめ

本研究では、VA-SWNT 膜が非常に高い撥水性を示すことを 見出した.しかしながら,試料によって接触角に大きな差異が 観測され(115°≤θ≤150°,或いはそれ以上),その差異を与え る原因の解明は今後取り組むべき課題である.予備的実験では, 高温・減圧下で乾燥空気を流し,試料の上面を燃焼させた前後 の接触角の変化を検証し,接触角は若干低下するという結果が 得られた.この結果は、本試料の高い撥水性の原因として、膜 上面に存在するランダムなSWNTバンドルの存在を一つの可能 性として示唆しているが、燃焼過程において SWNT 表面に何ら かの化学基が吸着した可能性も否定できず、現時点では膜上面 のランダム SWNT 層が高撥水性の原因とは断定できない.

SWNT 膜の撥水性は、様々な応用を考える上で重要であり、 従って濡れ性を決める要因の解明は重要である.例えば、最近、 温水を用いて VA-SWNT 膜を簡便に基板から剥離する方法が見 出された⁽¹¹⁾が、この手法では、用いる VA-SWNT 膜が高い撥水 性を有することが必要条件となっている.さらに、今後ナノス ケールの形状が撥水性に及ぼす影響の解明を進めることは、基 礎的視点からも重要な課題であると考えられる.

参考文献

- (1) 齋藤理一郎・篠原久典共編,カーボンナノチューブの基礎
 と応用,培風館 (2004).
- (2) S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi, M. Kohno,

4

Chem. Phys. Lett. 360 (2002) 229.

- (3) Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Chiashi, S. Maruyama, Chem.
 Phys. Lett. 377 (2003) 49.
- (4) Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi, M. Hu, M. Ogura, T. Okubo, S. Maruyama, Chem. Phys. Lett. 385 (2004) 298.
- (5) S. Maruyama, E. Einarsson, Y. Murakami, T. Edamura, Chem.
 Phys. Lett. 403 (2005) 320.
- (6) Y. Murakami, S. Chiashi, E. Einarsson, S. Maruyama, Phys.
 Rev. B 71 (2005) 085403.
- Y. Murakami, E. Einarsson, T. Edamura, S. Maruyama, Phys.
 Rev. Lett. 94 (2005) 087402.
- (8) Y. Murakami, E. Einarsson, T. Edamura, S. Maruyama, Carbon
 43 (2005) 2664.
- (9) P. T. Araujo, S. K. Doorn, S. Kilina, S. Tretiak, E. Einarsson,
 S. Maruyama, H. Chacham, M. A. Pimenta, A. Jorio, Phys. Rev. Lett. 98 (2007), 067401.
- (10) Y.-W. Song, E. Einarsson, S. Yamashita, S. Maruyama, Opt.Lett., (2007), in press.
- (11) Y. Murakami and S. Maruyama, Chem. Phys. Lett. 422 (2006)

575.



図1. 石英基板上に垂直配向した単層カーボンナノチューブ膜

の走査型電子顕微鏡 (SEM) 写真.

(a) 膜断面の全体像,(b) 上部を含む拡大像



図2. 垂直配向単層カーボンナノチューブ膜(サンプルA) にのせた水液滴の光学写真



図3.(a) 垂直配向膜の大気中での加熱処理(500~645℃)による吸光度の変化と膜厚の変化(b)サンプルBの加熱処理前後の接触角の分布とサンプルAの接触角の分布.